

111RKI SERIES

PHASE CONTROL THYRISTORS

Stud Version

110A

Features

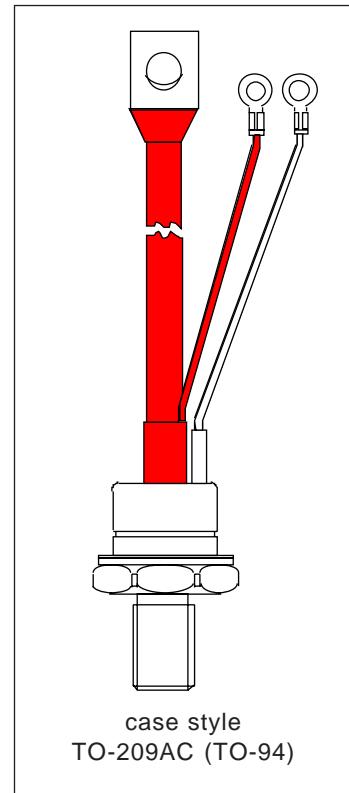
- High current and high surge ratings
- $dv/dt = 1000V/\mu s$ option
- Ceramic housing
- Threaded studs UNF 1/2 - 20UNF2A
- Types up to 1200V V_{RRM}/V_{DRM}
- $di/dt = 300A/\mu s$

Typical Applications

- DC motor controls
- Controlled DC power supplies
- AC controllers

Major Ratings and Characteristics

| Parameters | 111RKI | Units |
|-------------------|-------------|-------------------|
| $I_{T(AV)}$ | 110 | A |
| @ T_c | 90 | °C |
| $I_{T(RMS)}$ | 172 | A |
| I_{TSM} | 2080 | A |
| @ 50Hz | 2180 | A |
| I^2t | 21.7 | KA ² s |
| @ 60Hz | 19.8 | KA ² s |
| V_{DRM}/V_{RRM} | 400 to 1200 | V |
| t_q typical | 110 | μs |
| T_j | - 40 to 140 | °C |



111RKI Series

Bulletin I25152 rev. C 05/97

International
IR Rectifier

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Voltage Ratings

| Type number | Voltage Code | V_{DRM}/V_{RRM} , max. repetitive peak and off-state voltage V | V_{RSM} , maximum non-repetitive peak voltage V | I_{DRM}/I_{RRM} max. @ $T_J = T_J$ max. mA |
|-------------|--------------|--|---|--|
| 111RKI | 40 | 400 | 500 | 20 |
| | 80 | 800 | 900 | |
| | 120 | 1200 | 1300 | |

On-state Conduction

| Parameter | 111RKI | Units | Conditions |
|--|--------|--------------------|---|
| $I_{T(AV)}$ Max. average on-state current @ Case temperature | 110 | A | 180° conduction, half sine wave |
| | 90 | °C | |
| $I_{T(RMS)}$ Max. RMS on-state current | 172 | A | DC @ 83°C case temperature |
| I_{TSM} Max. peak, one-cycle non-repetitive surge current | 2080 | | t = 10ms No voltage reapplied |
| | 2180 | | t = 8.3ms 100% V_{RRM} reapplied |
| | 1750 | | t = 10ms No voltage reapplied |
| | 1830 | | t = 8.3ms 100% V_{RRM} reapplied |
| I^2t Maximum I^2t for fusing | 21.7 | KA ² s | Sinusoidal half wave, Initial $T_J = T_J$ max. |
| | 19.8 | | |
| | 15.3 | | |
| | 14.0 | | |
| $I^2\sqrt{t}$ Maximum $I^2\sqrt{t}$ for fusing | 217 | KA ² /s | t = 0.1 to 10ms, no voltage reapplied |
| $V_{T(TO)1}$ Low level value of threshold voltage | 0.82 | V | (16.7% $\times \pi \times I_{T(AV)} < I < \pi \times I_{T(AV)}$), $T_J = T_J$ max. |
| $V_{T(TO)2}$ High level value of threshold voltage | 1.02 | | ($I > \pi \times I_{T(AV)}$), $T_J = T_J$ max. |
| r_{t1} Low level value of on-state slope resistance | 2.16 | mΩ | (16.7% $\times \pi \times I_{T(AV)} < I < \pi \times I_{T(AV)}$), $T_J = T_J$ max. |
| r_{t2} High level value of on-state slope resistance | 1.70 | | ($I > \pi \times I_{T(AV)}$), $T_J = T_J$ max. |
| V_{TM} Max. on-state voltage | 1.57 | V | $ I_{pk} = 350A$, $T_J = T_J$ max., $t_p = 10ms$ sine pulse |
| I_H Maximum holding current | 200 | mA | $T_J = 25^\circ C$, anode supply 6V resistive load |
| I_L Typical latching current | 400 | | |

Switching

| Parameter | 111RKI | Units | Conditions |
|---|--------|-------|---|
| di/dt Max. non-repetitive rate of rise of turned-on current | 300 | A/μs | Gate drive 20V, 20Ω, $t_r \leq 1\mu s$ $T_J = T_J$ max, anode voltage $\leq 80\% V_{DRM}$ |
| t_d Typical delay time | 1 | μs | Gate current 1A, $di_g/dt = 1A/\mu s$ $V_d = 0.67\% V_{DRM}$, $T_J = 25^\circ C$ |
| t_q Typical turn-off time | 110 | | $I_{TM} = 50A$, $T_J = T_J$ max., $di/dt = -5A/\mu s$, $V_R = 50V$ $dv/dt = 20V/\mu s$, Gate 0V 25Ω |

Blocking

| Parameter | 111RKI | Units | Conditions |
|---|--------|-------|---|
| dv/dt Maximum critical rate of rise of off-state voltage | 500 | V/μs | $T_J = T_J \text{ max. linear to } 80\% \text{ rated } V_{DRM}$ |
| I_{RRM} Max. peak reverse and off-state leakage current | 20 | mA | $T_J = T_J \text{ max, rated } V_{DRM}/V_{RRM} \text{ applied}$ |

Triggering

| Parameter | 111RKI | Units | Conditions |
|--|-------------------------|-----------------------|---|
| P_{GM} Maximum peak gate power | 12 | W | $T_J = T_J \text{ max, } t_p \leq 5\text{ms}$ |
| $P_{G(AV)}$ Maximum average gate power | 3.0 | | $T_J = T_J \text{ max, } f = 50\text{Hz, d\% = 50}$ |
| I_{GM} Max. peak positive gate current | 3.0 | A | $T_J = T_J \text{ max, } t_p \leq 5\text{ms}$ |
| $+V_{GM}$ Maximum peak positive gate voltage | 20 | V | |
| $-V_{GM}$ Maximum peak negative gate voltage | 10 | | $T_J = T_J \text{ max, } t_p \leq 5\text{ms}$ |
| I_{GT} DC gate current required to trigger | TYP. 180 80 40 | MAX. - 120 - | mA $T_J = -40^\circ\text{C}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 140^\circ\text{C}$ |
| V_{GT} DC gate voltage required to trigger | 2.5 1.6 1 | - 2 - | V $T_J = -40^\circ\text{C}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 140^\circ\text{C}$ |
| I_{GD} DC gate current not to trigger | 6.0 | mA | |
| V_{GD} DC gate voltage not to trigger | 0.25 | V | $T_J = T_J \text{ max}$ Max. gate current/voltage not to trigger is the max. value which will not trigger any unit with rated V_{DRM} anode-to-cathode applied |

Thermal and Mechanical Specification

| Parameter | 111RKI | Units | Conditions |
|--|------------------------------|----------------|--|
| T_J Max. operating temperature range | -40 to 140 | °C | |
| T_{stg} Max. storage temperature range | -40 to 150 | | |
| R_{thJC} Max. thermal resistance, junction to case | 0.27 | K/W | DC operation |
| R_{thCS} Max. thermal resistance, case to heatsink | 0.1 | | Mounting surface, smooth, flat and greased |
| T Mounting torque, ± 10% | 15.5 (137) 14 (120) | Nm (lbf-in) | Non lubricated threads Lubricated threads |
| wt Approximate weight | 130 | g | |
| Case style | TO-209AC (TO-94) | | See Outline Table |

111RKI Series

Bulletin I25152 rev. C 05/97

International
IR Rectifier

ΔR_{thJC} Conduction

(The following table shows the increment of thermal resistance R_{thJC} when devices operate at different conduction angles than DC)

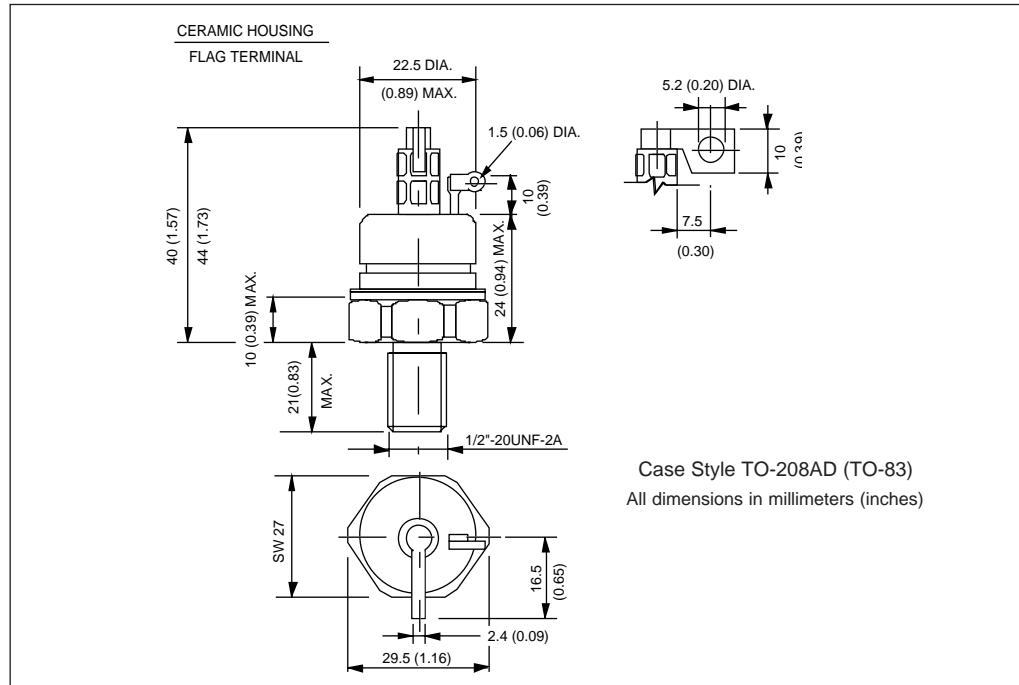
| Conduction angle | Sinusoidal conduction | Rectangular conduction | Units | Conditions |
|------------------|-----------------------|------------------------|-------|---------------------|
| 180° | 0.043 | 0.031 | K/W | $T_J = T_{J\ max.}$ |
| 120° | 0.052 | 0.053 | | |
| 90° | 0.066 | 0.071 | | |
| 60° | 0.096 | 0.101 | | |
| 30° | 0.167 | 0.169 | | |

Ordering Information Table

| Device Code | |
|-------------|-----|
| 11 | 1 |
| RKI | 120 |
| (1) | (2) |
| (3) | (4) |
| (5) | |

1 - $I_{T(AV)}$ rated average output current (rounded/10)
2 - 0 = Eyelet terminals (Gate and Auxiliary Cathode Leads)
 1 = Fast - on terminals (Gate and Auxiliary Cathode Leads)
 2 = Flag terminals (For Cathode and Gate Terminals)
3 - Thyristor
4 - Voltage code: Code x 10 = V_{RRM} (See Voltage Rating Table)
5 - Critical dv/dt: None = 500V/ μ sec
 S90 = 1000V/ μ sec

Outline Table



Outline Table

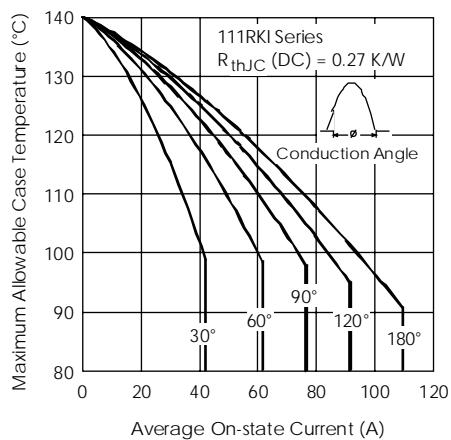
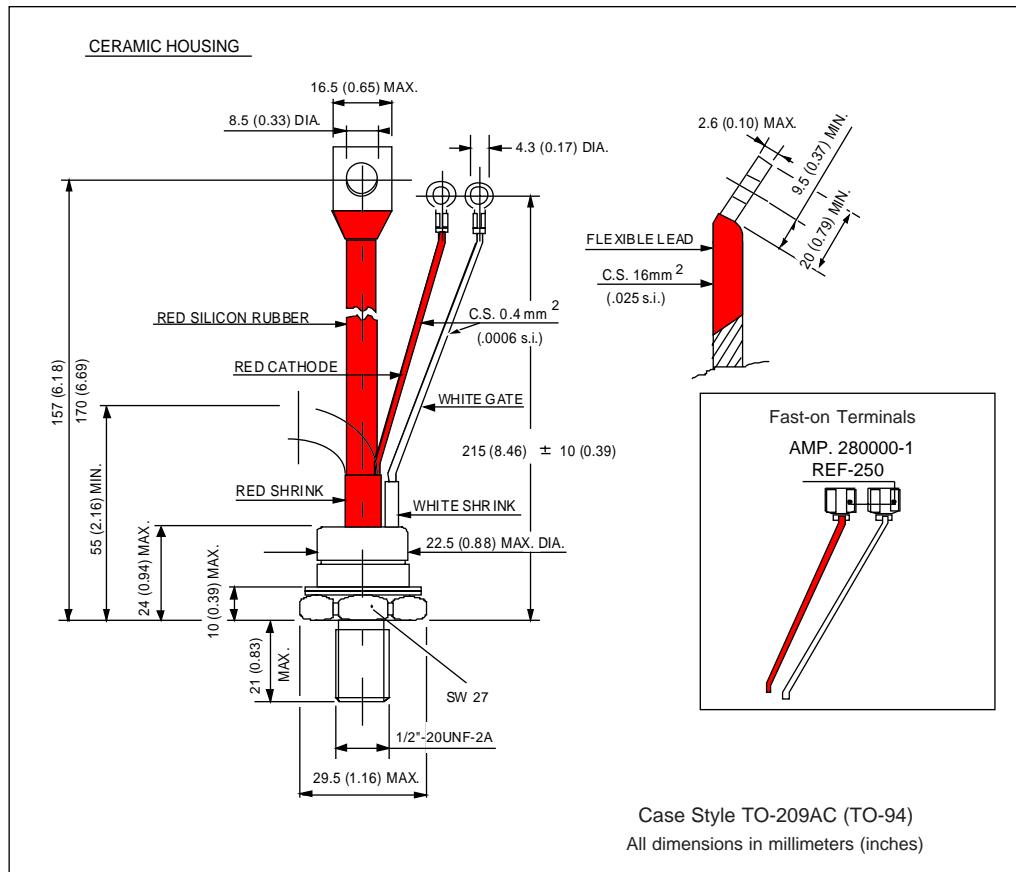


Fig. 1 - Current Ratings Characteristics

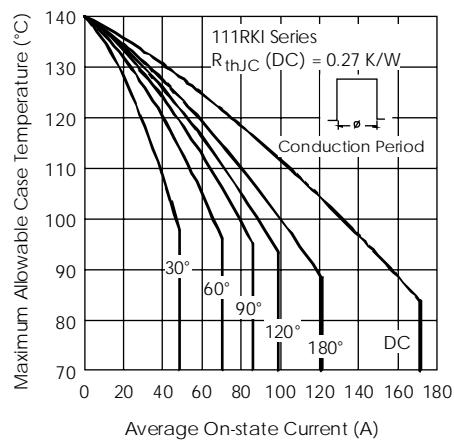


Fig. 2 - Current Ratings Characteristics

111RKI Series

Bulletin I25152 rev. C 05/97

International
Rectifier

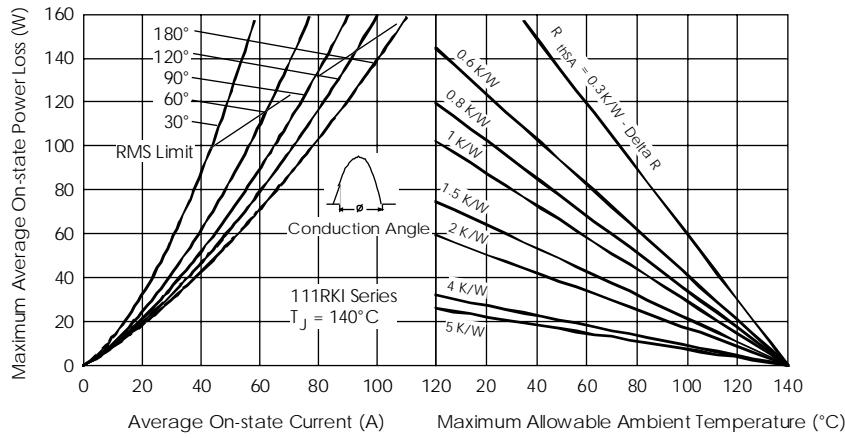


Fig. 3 - On-state Power Loss Characteristics

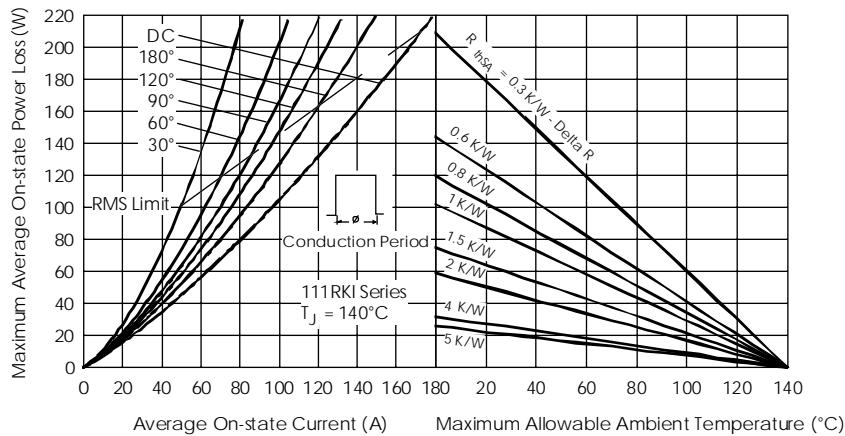


Fig. 4 - On-state Power Loss Characteristics

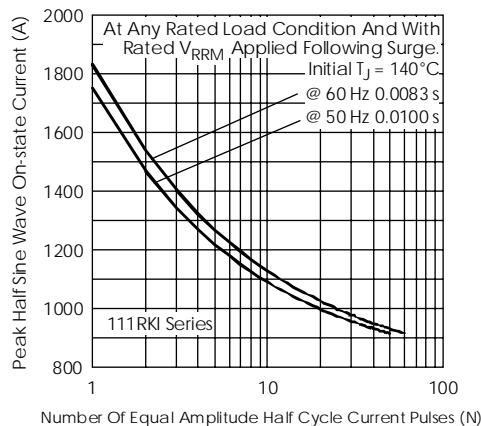


Fig. 5 - Maximum Non-Repetitive Surge Current

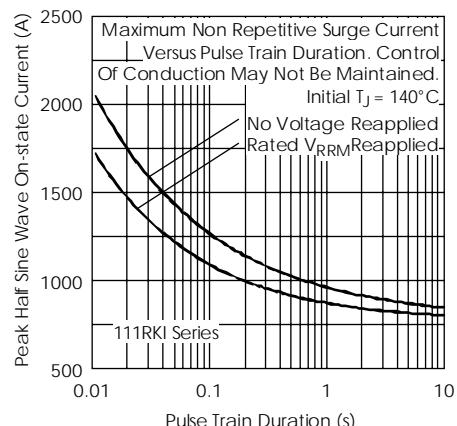


Fig. 6 - Maximum Non-Repetitive Surge Current

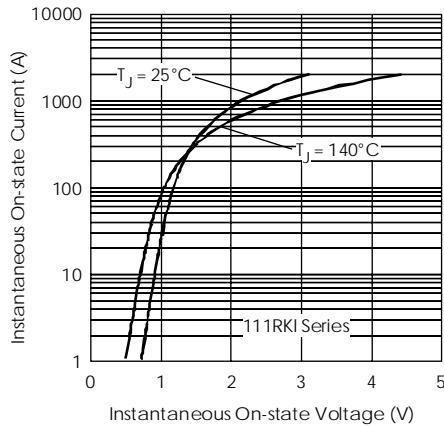


Fig. 7 - On-state Voltage Drop Characteristics

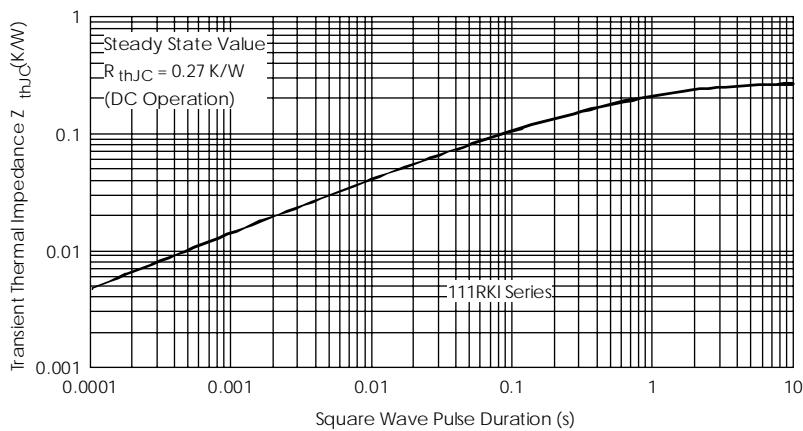


Fig. 8 - Thermal Impedance Z_{thJC} Characteristic

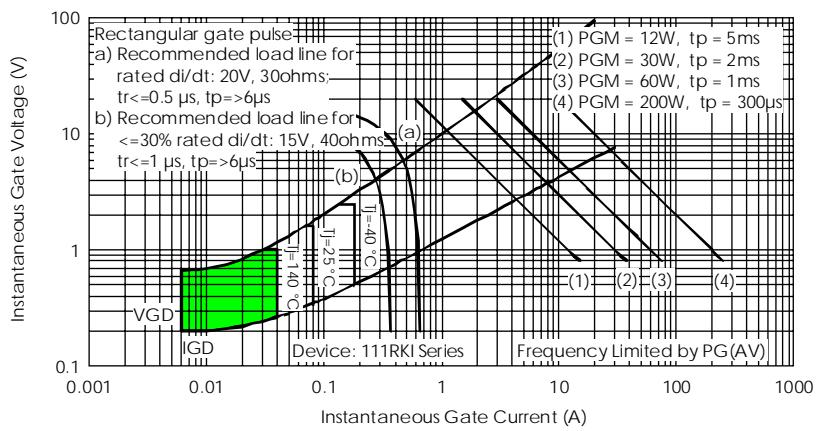


Fig. 9 - Gate Characteristics



OCEAN CHIPS

Океан Электроники

Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А